SPACIAL RESOLUTION OF SCREEN MONITOR FOR XFEL/SPring-8

 Kenichi Yanagida^{1A)}, Shinobu Inoue^{B)}, Hiromitsu Tomizawa^{A)}, Hirokazu Maesaka^{B)}, Shinichi Matsubara^{B)} and Yuji Otake^{B)}
^{A)}JASRI, XFEL Joint Project /SPring-8
1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198
^{B)}RIKEN, XFEL Joint Project /SPring-8

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5148

Abstract

Screen monitors for the XFEL/SPring-8 were optimally designed to satisfy required transverse spacial resolutions. The main factors that contribute to a spacial resolution come from an aberration, diffraction, defocus due to a depth of field and the pixel size of CCD. Our optical systems were designed not to increase these four factors. Calculated resolutions of the optical systems are 2.5 μ m (OTR, 4x magnification), 3.1 μ m (Ce:YAG, 4x magnification), 25.0 μ m (OTR, 0.44x magnification) and 16.6 μ m (Ce:YAG, 0.44x magnification). The optical systems were examined at the SCSS Test Accelerator by using electron beams that were horizontally focused within a several ten micrometer. Because of comparable or larger beam size, an obtained image was too large to evaluate the resolution, however the optical systems were thought to satisfy the required resolutions.

XFEL 用スクリーンモニタの空間分解能

1. はじめに

線型加速器やビーム輸送系に於いて一般的に使用されるスクリーンモニタの横方向空間分解能は数十μm であった。しかし、線型加速器ベースの将来計画で あるX線自由電子レーザー(XFEL)、エネルギー回 収型リニアック及びリニアコライダー等では、低エ ミッタンスビーム(1πm·mrad以下)のエミッタンス 測定等を行うため、10μm以下の分解能が要求され る。分解能には光学で決定される原理的な限界値が あり、上記の将来計画で必須とされる分解能はそれ に達するものである。

本論文では分解能に寄与する要因とその寄与の大 きさを述べると共に、原理的な空間分解能を達成す るためにはどのような問題が存在するかについて述 べる。さらに、SPring-8 で建設中の XFEL 計画^[1] (XFEL/SPring-8)に使用されるスクリーンモニタに ついて、その設計と性能の検証を行ったので報告する。

2. スクリーンモニタの概要

XFEL/SPring-8 の非分散部に使用されるスクリーン モニタでは、発光体として OTR 発生用の金属フォイ ル(OTR フォイル)もしくは蛍光発生用の Ce:YAG が使用される(図1参照)^[2]。OTR フォイルはビー ムエネルギー 30 MeV 以上、Ce:YAG は 300 MeV 以 下で使用する。



図 1: OTR フォイル (左)とCe:YAG (右)の写真



図 2: 光学系のレイアウト及び Zemax による光線追跡

OTR は電子が真空中から金属中(または金属中から真空中)へ遷移する境界点で発生する輻射で、1/γ (γはローレンツ因子)の円錐状強度角分布を持つ。 我々の OTR フォイルは、図2のようにビーム軸に対 して 45°傾けられており、ビーム軸に対して 90°の 方向に光が取り出される。

Ce:YAG は黄色透明な単結晶で、厚さ 0.1 mm の円 板に加工されている。等方的に放出された光の一部 はビーム下流側の金属鏡で反射され、OTR と同じく ビーム軸に対して 90°の方向に取り出される(図 2 参照)。

光学系にはビームエミッタンス測定などに使用される4倍光学系と一般的なプロファイル観測用の0.44 倍光学系がある。4倍光学系に使用されるレンズは幾何収差及び色収差を最小に抑えるように特別に設計 されたものであり^[3]、0.44倍光学系は市販のアクロ マティックレンズをリレーレンズとして組んだもので ある。両光学系では全ての光学定数(曲率半径や硝 材の屈折率、アッベ数等)が既知なため、収差等の 計算を行うことが可能である。

3. 分解能に寄与する要因

以下に結像光学系(Near Field)の分解能に寄与す る各要因と、その寄与の大きさについて述べる。

3.1 収差

幾何収差及び色収差の計算には光学設計・評価ソ フトウェア Zemax (ZEMAX DEVELOPMENT COR-PORATION)の光線追跡機能を使用した。入力した 主な光学素子は Ce:YAG、光取り出し窓、ND フィル タ、レンズ及び CCD 保護ガラス(図2参照)である。 なお、ND フィルタは Ce:YAG からの光量が強過ぎる (OTR の 1000 倍以上)ため点光量を 1/100 に低減さ せるのに使用する。

光線追跡の波長帯域は 400 - 800 nm (OTR) 及び 550 nm (Ce:YAG)とし、絞りが制限する物体空間で の開口数 NA_o は 0.213 (4 倍光学系) 及び 0.074 (0.44 倍光学系)とした。収差は NA_o に比例するので、絞 りを絞って NA_o を小さくすると収差は小さくなる。

計算のため、仮想的なシャープエッジ 50 μm (4 倍 光学系)及び 0.5 mm (0.44 倍光学系)の正方形物体 を物体面に置き、得られた像(図3参照)のエッジ 部分を解析した。



図 3: 仮想的な物体(光源)からの光線追跡により得 られた像

収差(点像のボケ)の大きさはエッジ部分の幅(25-75%変化幅の半値)とした。図4は図3各像の中心付 近、鉛直方向の強度分布で、立ち上がりエッジ部分を 拡大している。図より収差による寄与はOTRの4倍 光学系で1.0μm、Ce:YAGの0.44倍光学系で13.5μm と得られた。



図 4: 図 3 各像の立ち上がりエッジ部分

3.2 回折パターン

結像光学系を構築した場合、レンズが無収差であ るとしても回折により点像は有限な大きさを持った 像(回折パターン)となる。回折パターンの計算に はFraunhofer回折の式が用いられる。ここではレン ズや円形絞りを考えているので、円形開口の回折パ ターンを考える。

Fraunhofer 回折を計算する際、開口数が小さく(0.3 以下)、且つ光がランダム偏光の場合はスカラービー ムとして扱われるが、それ以外はベクトルビームとし て扱われなければならない。今回、Ce:YAG の場合は スカラービームとして、OTR の場合はベクトルビー ムとして扱われる。

Ce:YAG など等方的に光を放出する場合、その回折 パターンはエアリーパターンとして知られ、その半 値半幅 (Half Width at Half Maximum)は光の波長を λ とした場合、次のようになる。

$$\frac{\lambda}{4NA_o} \tag{1}$$

一方、OTR の回折パターンは Fraunhofer 回折の式 に発光の角度分布をたたみ込み、フーリエ積分を遂行 することによって得られる^{[4][5]}。回折パターンは円 環状で、電子ビームのエネルギーには依らない。OTR はラジアル偏光を持つベクトルビームとして扱われ、 2次の伝搬(高次)モードまで考えると、回折パター ンの大きさ(半値半幅)はエアリーパターンの3倍 程度になると思われる。

$$\sim \frac{3\lambda}{4NA_2}$$
 (2)

式 (1) 及び式 (2) から判るように回折パターンの大 きさは NA_o に反比例するため、絞りを絞って NA_o を 小さくすると回折パターンは大きくなる。 $\lambda \ge 600$ nm (OTR の代表波長) 及び 550 nm (Ce: YAG)とすると、 分解能への寄与は 2.1 μ m (OTR の 4 倍光学系) 及び 1.9 μ m (Ce: YAG の 0.44 倍光学系) と得られる。

3.3 発光点が深度を持つ場合

発光点がレンズに対して被写界深度を持つ場合、ピンボケにより分解能が悪化する。ピンボケの程度は 幾何学的な計算から以下のように表される。

$$\frac{tNA_o}{2n} \tag{3}$$

ここで、t は被写界深度の深さで、Ce: YAG の場合は 結晶厚の半値、OTR の場合はビームサイズとなる。 n は発光体の屈折率で、Ce: YAG の場合は 1.82、OTR の場合は 1 (真空)である。式 (3) から判るようにピ ンボケの大きさは NA_o に比例するため、絞りを絞っ て NA_o を小さくするとピンボケは小さくなる。

OTR の場合、ピンボケは最大でビームサイズの5% 程度となるが、ビームサイズに比して小さいとして無 視できる。Ce:YAG の 0.44 倍光学系の場合は 1.0 μm となる。

ピント調整が不十分な場合のピンボケも式(3)より 計算可能で、例えば4倍光学系に於いて発光体–レン ズ間距離がベストフォーカスから 0.1 mm ずれると、 11 μ m のボケが生じる(n = 1で計算)。

3.4 CCD のピクセルサイズによる最小像サイズ

CCD カメラを使用して像を取得する場合、観測される最小像サイズは CCD のピクセルサイズとなり、それ以下にはならず、分解能に寄与する要因と考える。 σ_{pel} を CCD のピクセルサイズ、光学倍率を Mとすると、分解能への寄与は以下のようになる。

$$\frac{\sigma_{pel}}{2M} \tag{4}$$

4 倍光学系で使用される CCD カメラのピクセルサ イズは 6.5 μm で分解能への寄与は 0.8 μm に、0.44 倍光学系で使用される CCD カメラのピクセルサイズ は 8.3 μm で分解能への寄与は 9.4 μm になる。

3.5 電子散乱、制動 X 線、発光の飽和

Ce: YAG を使用する場合、電子の多重散乱、制動輻射 X 線による蛍光発生及び発光強度飽和による分解能の悪化が起こる^{[6][7]}。例えばエネルギー 250 MeV の電子ビームプロファイルを 0.1 mm 厚の Ce: YAG で 観測する場合、電子の多重散乱のよる分解能への寄与は 0.1 μm 程度、制動輻射による X 線の拡がりによる寄与は 0.1 μm 程度となる。

Ce:YAGの発光強度飽和による分解能への寄与を計 算することは困難である。飽和密度以下で使用する ことが望ましい。文献^[7]によると、発光の減衰時定 数(80 ns)以内に電子密度が0.3 pC/µm²以上になる と発光強度の飽和が起こると報告されている。我々 のビーム試験では最大でも0.03 pC/µm²程度であり、 発光強度は飽和しなかったと考える。

これらはビームエネルギーが低い場合や高電子密 度の場合に起こる現象で、個別に分解能への寄与を 見積もるものとする。

3.6 計算結果

上記各要因は1次独立な事象であり、寄与を計算 し、それらの二乗和平方根を取ることで分解能(合計) を算出した(表1参照)。収差による寄与がCe:YAG の場合に小さくなるのは単色での計算であることと、 物質中(屈折率1より大)での発光であることが原 因である。

OTR の4倍光学系では回折による寄与が最大とな るが、開口数はこれ以上大きく取れず、改善の余地 は無いだろう。Ce:YAGの4倍光学系では深度による 寄与が支配的になるが、発光する部分の厚みを薄く、 例えば20 μ m にすると他の要因と同程度にできる。 4倍光学系の分解能はFFGD(Fixed Frequency Grid Distortion)ターゲットを使用した試験で2 μ m 程度 と測定されており^[3]、今回計算された分解能とほぼ 一致している。

0.44 倍光学系は収差が支配的となるが、これは市 販のレンズを組み合わせて使用しているためで、専 用のレンズを製作すれば収差は小さくなるし、絞り によって開口数を小さくすれば分解能は良くなる。

表 1: 計算された分解能 [µm]

倍率	発光体	収差	回折	深度	CCD	合計
4	OTR	1.0	2.1	0.0	0.8	2.5
4	Ce:YAG	0.4	0.6	2.9	0.8	3.1
0.44	OTR	22.3	6.1	0.0	9.4	25.0
0.44	Ce:YAG	13.5	1.9	1.0	9.4	16.6

4. ビームプロファイルの確認

光学系を評価するために、SCSS 試験加速器^[8] に スクリーンモニタを設置しOTR と Ce:YAG 蛍光を観 測した。図 5 は使用した光学系である。4 倍光学系は レンズ及び CCD カメラがモーター付きステージの上 にマウントされており、ピントは像を見ながら遠隔 にて調整可能である^[2]。一方、0.44 倍光学系は現場 でのピント調整になるためベストフォーカスは得に くい。特に Ce:YAG の場合は照明を ON しても、透 明で何も反射しないため調整は困難である。



図 5: SCSS 試験加速器に設置されたスクリーンモニ タ光学系 (上:4 倍光学系、下:0.44 倍光学系)

図6及び図7は4倍光学系及び0.44倍光学系を使 用して得られた像である。加速器上流の四極電磁石 を調整して水平方向に電子ビームを絞った。0.44倍光 学系では視野が広いため照明をONするとOTRフォ イルのフレーム等が見られる。

図8及び図9は図6及び図7の像強度を水平方向



図 6:4 倍光学系を使用して得られた像(左:OTR、 右:Ce:YAG、照明 OFF 時)



図 7: 0.44 倍光学系を使用して得られた像 (左:OTR、 右:Ce:YAG、照明 ON 時)

への射影した強度分布である(照明 OFF 時)。横軸 は CCD 面上の位置ではなく、発光点の位置に換算さ れている。グラフから射影強度分布の半値半幅を読 み取ったものを表2の換算像サイズに示す。ビーム サイズは換算像サイズから分解能(表1の合計)を 差し引いて算出したものである。



図 8: 図 6 の水平方向射影強度分布(照明 OFF 時)



図 9: 図 7 の水平方向射影強度分布 (照明 OFF 時)

表 2 から、実際のビームサイズは 4 倍光学系試験 時で 14 μm 以下、0.44 倍光学系試験時で 30 μm 以下 であったと思われる。OTR と Ce:YAG の場合で差が あるのは、Ce:YAG の方が ND フィルタ等光学要素が 多く、ピンボケをより十分に抑え切れなかった為だと 思われる。特に Ce:YAG の 0.44 倍光学系ではピンボ ケが大きく、ビームサイズが大きく表れた。この時の 被写界深度のずれは 0.9 mm 程度あったと思われる。

今回の試験ではビームサイズが大きく、設計分解能 が得られているかどうかは明快でない。しかし、ピン ボケ以外の光学系に関する問題は現れず、FFGD ター

表 2:像サイズ(換算値)及びビームサイズ [µm]

倍率	発光体	換算像サイズ	ビームサイズ			
4	OTR	14.3	14.1			
4	Ce:YAG	18.7	18.4			
0.44	OTR	38.9	29.8			
0.44	Ce:YAG	48.4	45.5			

ゲットを使用した試験を参考にして総合的に考える と、ピント調整さえ正確に行えば設計通りの性能が 得られると判断する。

5. まとめ

XFEL/SPring-8 で使用されるスクリーンモニタの 分解能は 4 倍光学系で 2.5 μm (OTR)、3.1 μm (Ce:YAG)と計算された。どちらも 10 μm 以下である が、Ce:YAG の場合は発光強度の飽和が予想されるた め、小さなビームサイズの測定に使用すべきでない。 一方、0.44 倍光学系では 25.0 μm (OTR)、16.6 μm (Ce:YAG)と計算された。

OTR の4倍光学系はエミッタンス測定に使用され る。その分解能へは回折が最も大きく寄与している。 これは、OTR が1/γの円錐状強度角分布を持ち、且 つラジアル偏光を持つために、回折パターンの大き さがエアリーパターンの3倍程度と見積もられるた めである。回折による寄与を小さくするには開口数 を大きく取れば良いが、実際には開口数をこれ以上 大きく取れず、回折が実質的に分解能を決めている。 OTR の回折に関しては、今後より詳細に議論を進め て行く必要があるだろう。

SCSS 試験加速器でビーム試験を行ったが、ビーム サイズが大きく、設計分解能が得られているかどう かは明快ではなかった。問題としてはピント調整不 十分によるピンボケが比較的大きいことが判明した。 ピント調整を正確に行えば光学系は設計通りの性能 を発揮すると思われる。

参考文献

- [1] T. Shintake, et al., "Construction Status of XFEL/SPring-8", in these proceedings.
- [2] S. Inoue, et al., "Screen Monitor Prototype for XFEL/SPring-8", Proc. of the 5th Particle Accel. Soc. of Japan, Higashihiroshima, August 2008, pp. 545-547.
- [3] K. Yanagida, et al., "Optics of Screen Monitor for XFEL/SPring-8", Proc. of the 5th Particle Accel. Soc. of Japan, Higashihiroshima, August 2008, pp. 542-544.
- [4] D. Xiang, et al., Nucl. Instr. and Meth. A 570 (2007) 357.
- [5] M. Castellano, et al., Phys. Rev. ST-AB 1 (1998) 062801.
- [6] W. S. Graves, et al., "A High Resolution Electron Beam Profile Monitor", Proc. of the 1997 Particle Accel. Conf., Vancouver, May 1997, pp. 1993-1995.
- [7] A. H. Lumpkin, et al., Nucl. Instr. and Meth. A **429** (1999) 336.
- [8] H. Tanaka, et al., 「加速器」vol. 5 (2008), 237.